

SIPMOS Small-Signal Transistor Dice

$V_{DS(max)}$	$R_{DS(on)max}$	$V_{GS(th)}$	Die type	Recommended bond wire diameter ¹⁾ μm	Die topology	Page
V	Ω	V				
-50	10	-0.8...-2.0	SIS C 0.5P05E	22	LA	1183
	1	-0.8...-2.0	SIS C 3.2P05E	22	LC	1183
-60	10	-1.0...-2.0	SIS C 0.5P06E	22	LA	1183
-100	2.2	-0.8...-2.0	SIS C 3.2P10E	22	LC	1183
-200	6	-0.8...-2.0	SIS C 3.2P20E	22	LC	1183
-240	20	-0.8...-2.0	SIS C 1.4P24E	22	LB	1183
50	0.3	0.8...2.0	SIS C 3.2N05E	50	LC	1183
	3.5	0.8...1.6	SIS C 0.5N05E	22	LA	1183
60	5	0.8...2.0	SIS C 0.5N06E	22	LA	1183
65	3.5	1.4...2.3	SIS C 0.5N65E	22	LA	1183
100	6	1.6...2.6	SIS C 0.5N10E	22	LA	1183
	6	0.8...2.0	SIS C 0.5N10E	22	LA	1183
	0.8	0.8...2.0	SIS C 3.2N10E	50	LC	1183
200	3.5	-1.8...-0.7	SIS C 3.2N20D	22	LC	1183
	28	0.8...2.0	SIS C 0.6N24E	22	LD	1183
	2	0.8...2.0	SIS C 3.2N20E	25	LC	1183
240	8	0.6...1.2	SIS C 1.4N24E	25	LB	1183
	6	0.8...2.0	SIS C 1.4N24E	25	LB	1183
	16	0.8...2.0	SIS C 0.6N24E	22	LD	1183
	20	-1.8...-0.7	SIS C 1.4N24D	25	LB	1183
250	100	-1.8...-0.7	SIS C 0.6N25D	22	LD	1183
400	28	1.5...2.5	SIS C 1.4N40E	25	LE	1183
600	60	-1.8...-0.7	SIS C 1.4N60D	25	LE	1183
	45	1.5...2.5	SIS C 1.4N60E	25	LE	1183

L $\hat{=}$ Low

¹⁾ Note: The recommended bond wire diameter is the same for gate and source.